

# 深圳晶益電子有限公司

## 溫度補償晶體振蕩器(TCX0)

### 一. 主要技術規範

頻率範圍	1~160.000MHz	工作電壓	+5VDC±5%(或者3.3V可選)
頻率溫度穩定度及工作溫度	見附表1	儲存溫度	-55~+125℃
輸出形式、負載特性及工作電流	見附表2	相位噪聲	10 Hz: <-70dBC/Hz
頻率準確度	±1.0ppm		100 Hz: <-100dBC/Hz
頻率調整範圍	≥±5ppm(電調或者機調可選)		1K Hz: <-130dBC/Hz
老化率	±1.0ppm/年(最大)		10K Hz: <-140dBC/Hz
頻率負載穩定度	負載波動±10%時最大為±0.1ppm		100KHz: <-145dBC/Hz
頻率電壓穩定度	電壓偏離標定值±5%時最大為±0.2ppm	封裝	DIP14(20.4*13.2*8.0)

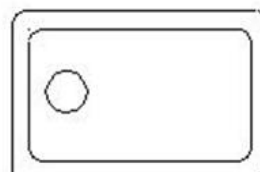
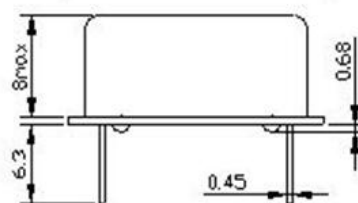
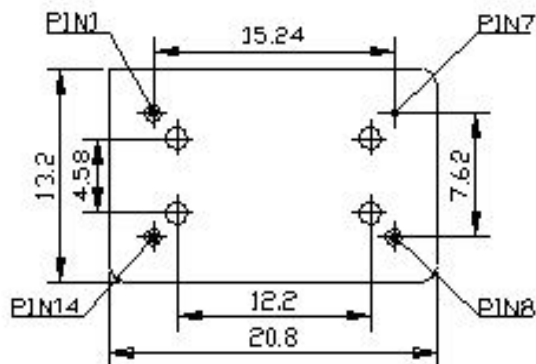
### 二. 頻率溫度穩定度(附表1)

代碼	頻率溫度穩定度	溫度範圍
A	±0.5ppm	0~+50℃
B	±1.0ppm	-10~+60℃
C	±1.5ppm	-20~+70℃
D	±2.0ppm	-30~+75℃
E	±2.5ppm	-35~+80℃
F	±3.0ppm	-40~+80℃

### 三. 輸出形式、負載特性及工作電流(附表2)

輸出波形	輸出類型編碼	頻率範圍	振蕩狀態	輸出特性
削峰正弦波	0	8MHz~40MHz	F: 基頻	負載: 10kΩ/10pF 輸出電平>1Vp-p 電流最大10mA
TTL	1	1MHz~40MHz	F: 基頻	負載: 最多10個低功耗TTL門 "1"電平: >+2.4VDC; "0"電平: <+0.2VDC 占空比: 40/60 上升/下降時間: 6ns 電流: 最大20mA
HCMOS	2	1MHz~40MHz	F: 基頻	負載: 最多10個低功耗TTL門 "1"電平: >90%VDC; "0"電平: <10%VDC 占空比: 40/60 上升/下降時間: 6ns 電流: 最大20mA
ACMOS	3	1MHz~40MHz	F: 基頻	負載: 最多10個低功耗TTL門 "1"電平: >90%VDC; "0"電平: <10%VDC 占空比: 40/60 上升/下降時間: 6ns 電流: 最大20mA
Sine Wave	4	1MHz~40MHz	F: 基頻	負載: 標稱值50Ω 輸出電平: 大于2dBm 諧波抑制: 大于-25dB 雜波抑制: 大于-75dB 電流: 最大10mA

### 四. 結構示意圖



PIN	FUNCTION
1	Vcon/NC
7	GND
8	Output
14	Power Supply